关

03



性能特点:

频带: DC~20GHz插入损耗: ≤2.5dB类型:吸收式单刀四掷

输入/输出回波损耗: ≥17/≥13dB芯片尺寸: 2.00mm×1.50mm×0.1mm

产品简介:

HH-SW40020 是一款 GaAs 单刀四掷吸收式开关芯片,该芯片具有带内插损小、体积小、易集成等特点。其频率范围覆盖 DC ~20GHz,插入损耗≤2.5dB。

电参数:(TA=25℃)

参数名称	频率(GHz)	Min	Тур	Max	单位
插损	DC~20	-	2.5	2.6	dB
隔离度	DC~20	-	45	-	dB
回波损耗	DC~20 (RF_IN)	-	17	-	dB
	DC~20 (RF1/RF2/RF3/RF4)	-	13	-	dB
输入 1dB 压缩点	DC~20	-	25	-	dBm
开关时间	-	-	10	-	ns

使用限制参数:

输入功率	+25dBm		
存储温度	-65℃~150℃		
使用温度	-55℃~85℃		

真值表:

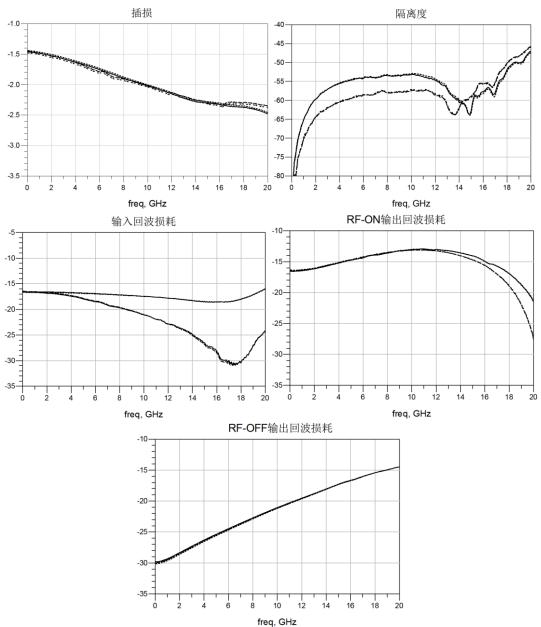
V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	RFIN-RFOUT
-5	0	0	-5	0	-5	0	-5	RFOUT1
0	-5	-5	0	0	-5	0	-5	RFOUT2
0	-5	0	-5	-5	0	0	-5	RFOUT3
0	-5	0	-5	0	-5	-5	0	RFOUT4

197

03

典型曲线:

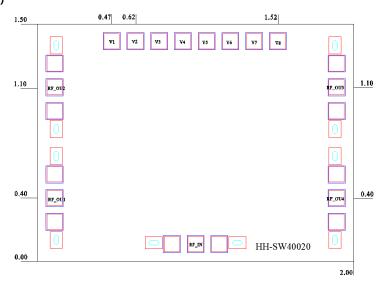
海威华芯 HiWAFER



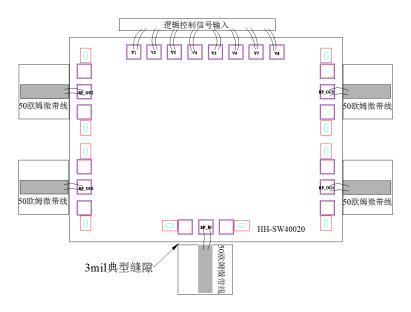
关



尺寸图: (单位 mm)



建议装配图:



使用说明:

存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在氮气环境下保存。

清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。

常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 输入输出各用1根(建议直径25um金丝)键合线,键合线长度300um最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时

起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板)

地址:成都双流区西南航空港经济开发区物联大道 88 号 电话: 028-65796021 65796086 传真:028-65796999